



中国科学院科学出版基金资助出版

半导体学报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 23 卷 第 1 期 2002 年 1 月

目 次

研究快报

- Electrical Transport Properties of Annealed Undoped InP Zhao Youwen, Luo Yilin, Sun Niefeng, S. Fung, C. D. Beling, Sun Tongnian and Lin Lanyin (1)
- A BEEM Study on Effects of Annealing Temperature on Barrier Height Inhomogeneity of CoSi₂/Si Contact Formed in Co-Ti-Si Systems Zhu Shiyang, Qu Xinping, Ru Guoping, Li Bingzong, C. Detavernier, R. L. van Meirhaeghe and F. Cardon (6)
- New Forward Gated-Diode Technique for Separating Front Gate Interface- from Oxide-Traps Induced by Hot-Carrier-Stress in SOI-NMOSFETs He Jin, Zhang Xing, Huang Ru and Wang Yangyuan (11)
- Near-Infrared Si_{0.7}Ge_{0.3}/Si p-i-n Photodetector Fabricated on SOI in CMOS Technology Guo Hui, Guo Weilian, Zheng Yunguang, Li Chen, Chen Peiyi, Li Shurong and Wu Xiawan (16)

研究论文

- 光伏研究硅单晶表面态真空敏感机理 颜永美 孙宜阳 丁小勇 周海文 (21)
- (Ga, Mn, As) /GaAs 的发光谱 杨君玲 陈诺夫 叶小玲 何宏家 (26)
- 金属-铁电体-GaN 结构研究 半朝霞 张 荣 李卫平 殷 江 沈 波 周玉刚 陈 鹏 陈志忠 顾书林 施 毅 刘治国 郑有焯 (30)
- 钝化多孔硅的光致发光 李宏建 彭景翠 许雪梅 瞿 述 夏 辉 (34)
- 多孔硅 PL 谱的影响因素分析 柯见洪 郑亦庄 池贤兴 程新红 (38)
- 单晶硅中氢与辐照缺陷的相互作用 王启元 林兰英 王建华 邓惠芳 谭利文 王 俊 蔡田海 郁元桓 (43)
- 空间实用背场 Si 太阳能电池和 GaAs/Ge 太阳能电池性能随质子辐照剂量变化的比较 王 荣 周宏余 司戈丽 姚淑德 张新辉 郭增良 翟佐绪 王勇刚 朱升云 (49)
- 非掺半绝缘磷化铟晶片的制备及其均匀性 董宏伟 赵有文 焦景华 赵建群 林兰英 (53)
- 采用 As₂ 和 As₄ 模式的新型全固源 InAsP 分子束外延生长 任在元 郝智彪 何 为 罗 毅 (57)
- 通过直接栅电流测量研究 PMOSFET's 热载流子损伤 张进城 郝 跃 刘海波 (61)
- 沟道热载流子导致的 SOI NMOSFET's 的退化特性 刘红侠 郝 跃 朱建纲 (65)
- 利用 FN 振荡电流估计金属-氧化物-半导体场效应管 Si-SiO₂ 界面宽度 杨 尧 毛凌锋 (70)
- 不同工艺超薄栅氧化层的抗击穿特性 韩德栋 张国强 任迪远 陆 妩 严荣良 (74)
- 一种简化的基于 BPM 的 AWG 优化设计方法 潘小龙 赵梓森 (78)
- Small Signal Equivalent Circuit Model and Modulation Properties of Vertical Cavity-Surface Emitting Lasers Mao Luhong, Chen Hongda, Tang Jun, Liang Kun, Wu Ronghan, Nian Hua, Guo Weilian and Wu Xiawan (82)
- 聚合物热光移相器件的研究及其应用 杨晓红 杜 云 吴荣汉 赵榆霞 李 兆 周家云 沈玉全 (87)
- 纳电子器件谐振隧道二极管的研制 梁惠来 赵振波 郭维廉 张世林 牛萍娟 杨中月 郝景臣 张豫黔 王文君 魏碧华 周均铭 王文新 (91)
- 应用遗传算法实现 MOS 器件综合 谢晓锋 李 钊 阮 骏 姚 依 张文俊 杨之廉 (95)
- 基于刻蚀工艺的 IC 关键面积计算模型与实现方法 赵天绪 郝 跃 马佩军 (102)
- 一种新的无网格折线重布算法 谢 民 蔡懿慈 洪先龙 (107)